

## 專利權、技術讓與公告

公告主旨	有鑑於在面對市場、技術、產品的激烈競爭時，企業掌握優質專利可形成強有力的防護網，並可藉此累積企業技術能力，成為企業在國際間競爭的最佳籌碼；國立中央大學擬將其所擁有之優質專利，以 <u>授權或讓與</u> 方式提供國內廠商，以增加廠商國際競爭力及促進整體產業發展，並提升研發成果運用效益。歡迎各界洽詢。
公告時間	<b>115年1月5日</b>
公告內容	<p>一、申請資格：國內依中華民國法令組織登記成立之公司法人</p> <p>二、申請日期：即日起至<b>115年3月4日17時00分止</b></p> <p>三、申請方式：請逕向本校研發處 智權技轉組 詢問相關資訊</p> <p>四、讓與專利/技術內容：詳見附件清單</p> <p>(專利技術內容請參考本校技術媒合網網頁介紹 <a href="http://ipm.ncu.edu.tw/prod.asp">http://ipm.ncu.edu.tw/prod.asp</a>)</p>
聯絡人	研發處 產學營運中心智權技轉組林經理
聯絡電話	03-4227151 轉 27089
電子郵件	mileslin@g.ncu.edu.tw

### 專利

序號	本校編號	專利名稱	申請號/專利號	國別	發明代表人
1	111029TW	碳化矽基板或基板處理方法	1824662	中華民國	李天錫
2	111029US	碳化矽基板或基板處理方法 SILICON CARBIDE SUBSTRATE OR SUBSTRATE PROCESSING METHOD	12,501,676	美國	李天錫
3	111029JP	炭化ケイ素基板または基板処理方法	特許第7776872號	日本	李天錫
4	111052TW	材料表面處理設備、材料表面處理方法以及碳化矽材料表面處理方法	1842201	中華民國	李天錫
5	111052US	MATERIAL SURFACE TREATMENT EQUIPMENT, MATERIAL SURFACE TREATMENT METHOD AND SILICON CARBIDE MATERIAL SURFACE TREATMENT METHOD	20240158309-A1	美國	李天錫
6	111052JP	材料表面処理装置、材料表面処理方法および炭化ケイ素材料表面処理方法	特許第7770003號	日本	李天錫
7	112024TW	半導體基板處理方法 / METHOD OF PROCESSING SEMICONDUCTOR SUBSTRATE	1862232	中華民國	李天錫
8	112024US	半導體基板處理方法 / SEMICONDUCTOR SUBSTRATE PROCESSING METHOD	20250132162	美國	李天錫
9	112024JP	半導体基板の処理方法	特許第7654289号	日本	李天錫

## 技術

序號	技術名稱	發明代表人
1	半導體穿孔技術製程與機械製造	李天錫